

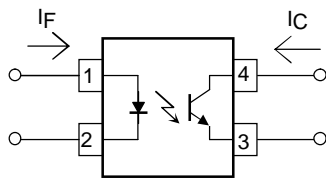
フォトランジスタカプラの基本特性と応用設計

フォトカプらは、一般に発光素子と受光素子との間に光透過性の絶縁物を介して光学的に結合し、接地電位の異なる回路間の信号インタフェースとして使用されるデバイスです。従来、集積回路の信号伝送や1次側と2次側を絶縁させた信号伝達などには電磁リレー、絶縁トランスなどが使用されていましたが、現在はインピーダンスの不整合解消、入出力間の絶縁能力の向上、誘導起電力の解消、ノイズシャ断の容易性などのメリットからフォトカプらが使用されています。さらに、システムの構成が LSI、マイコン化する状況の中で、基板占有面積の縮小化、信頼性向上によるメンテナンスフリーなどのメリットによりフォトカプらの応用が拡大しています。ここでは、当社のフォトカプらのラインアップの中でも汎用的なフォトランジスタカプらの電気的特性および応用設計について述べます。

1. フォトランジスタカプらの電気的特性

1-1. 変換効率 (CTR : Current Transfer Ratio)

図 1.1 に汎用 DIP4pin フォトランジスタカプら TLP785 のピン接続図を示します。変換効率(CTR)は入力側 LED に流す電流 I_F に対する出力側トランジスタのコレクタ電流 I_C の比率 (I_C/I_F) を%で表したものと定義します。図 1.2 に TLP785 の CTR 分布例を示します。CTR は、 I_F 条件によって変わりますが、標準条件の $I_F = 5 \text{ mA}$ 、 $V_{CE} = 5 \text{ V}$ で CTR は 50~600%をデザインしています。



$$CTR = 100 \times I_C / I_F [\%]$$

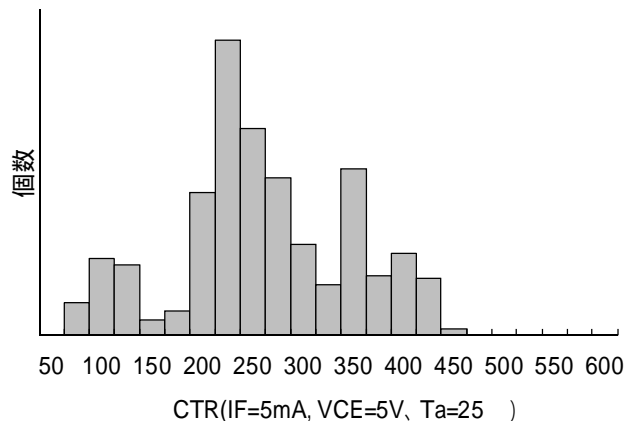


図 1.1 TLP785 内部回路と CTR の定義

図 1.2 TLP785 CTR 分布例

一般的に変換効率は下記に列記する各特性により変化します。各特性に留意いただくとともに、長時間使用時に発光出力の低下が起こることも考え合わせて、CTR には余裕をもった設計をお願いしています。具体的な設計の方法については 2-4 項で説明します。

・CTR- I_F 特性

CTR は I_F 依存性を持っているので、低 I_F で使用する場合、CTR 低下を考慮した回路設計が必要です。図 1.3 に特性例を示します。

・CTR-Ta 特性

一般にフォトトランジスタカプラの CTR は温度依存性を持っています。特に高温時の CTR は低下することが分かっています。これは、赤外 LED 発光効率の低下がフォトトランジスタの h_{FE} の増加よりも支配的になるためです。従って、装置内部の全温度範囲にわたって動作設計を考慮しなければなりません。

図 1.4 に特性例を示します。

・CTR- V_{CE} 特性

一般のトランジスタの h_{FE} と同様に、飽和状態でコレクタ電流が減少します。図 1.5 に特性例を示します。

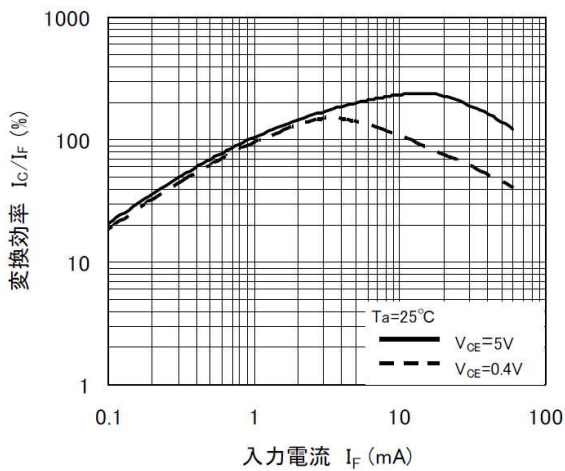


図 1.3 CTR (I_C/I_F) - I_F 特性例

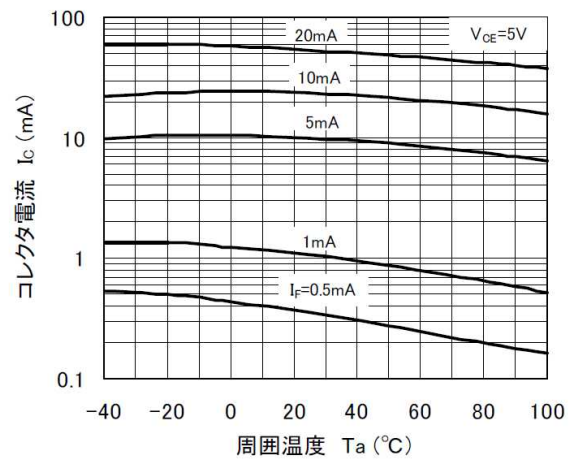


図 1.4 I_C - T_a 特性例

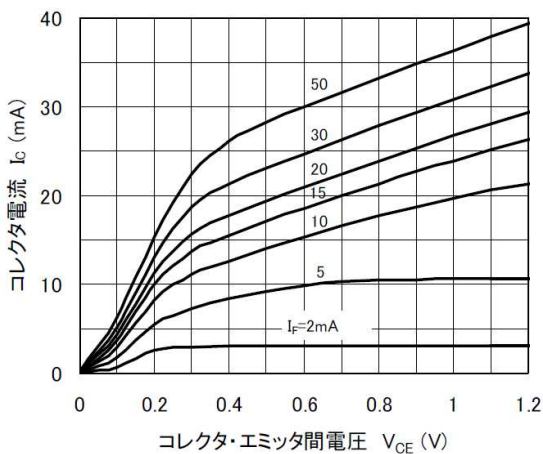


図 1.5 I_C - V_{CE} 特性例

1-2. 応答速度

出力フォトトランジスタを特に飽和スイッチングで使用する場合、その応答速度を考慮する必要があります。フォトトランジスタの応答性の項目の中では、 t_f (ON → OFF の移行) が一番長く、その特性は近似的に次式で与えられます。

$$t_f \sim 2.2 \times C_{ob} \times h_{FE} \times R_L \dots\dots\dots (1)$$

- C_{ob} : コレクタベース間容量
- h_{FE} : ベース注入の光電流対コレクタ電流の増幅率
- R_L : 負荷抵抗

例えば、TLP785 の場合は図 1.6 の特性となります。従って、特に 1 kbit/s 以上の応答速度が必要な場合は、 R_L の依存性に注意して設計しなければなりません。

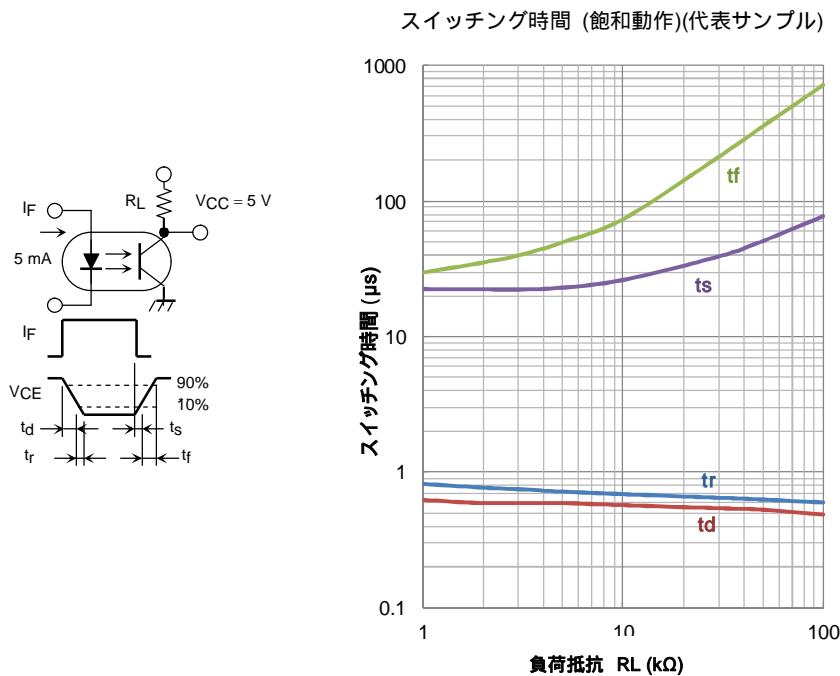


図 1.6 スwitchング時間- R_L 特性

2. フォトトランジスタカプラの応用回路設計

本項目ではフォトトランジスタカプラの回路設計法を示し、最後に代表的な信号伝送への応用例を紹介します。

2-1. 入力回路

2-1-1. 直流電圧駆動

スイッチの開閉により電源を ON、OFF することで駆動電流を制御する例を図 2.1 に示します。この場合、抵抗 R は、

$$R = \frac{V_{IN} - V_F}{I_F}$$

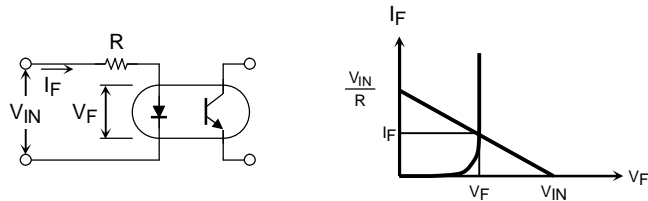


図 2.1

となります。例えば、 $I_F = 10 \text{ mA}$ で $V_{F(\text{max})} = 1.35 \text{ V}$ とした場合、 $V_{IN} = 5 \text{ V}$ のとき、R は

$$R = \frac{(5 - 1.35) \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 365 \Omega$$

となり、 $R = 360 \Omega$ にします。 V_F のバラツキや温度依存性のため、仮に $V_F = 0.9 \text{ V}$ となった場合、 $I_F \approx 11.4 \text{ mA}$ となります。

2-1-2. 逆電圧保護

発光ダイオードに逆方向サージ電圧が加わる場合は、図 2.2 のように発光ダイオードに Si ダイオード (例えば、1SS352 または可視および赤外発光ダイオード) を逆並列接続し、発光ダイオードに逆耐圧以上の逆電圧が印加されないようにしてください。

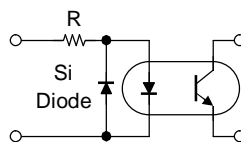


図 2.2

2-1-3. スレッシュホールド電圧

入力電圧が完全にゼロになりきれないときや、データ伝送ラインに不要電流があるレベルまで定常的に流れるような場合、発光ダイオードに対して並列抵抗 (R_S) を接続することでスレッシュホールド電圧を高くすることができます(図 2.3)。

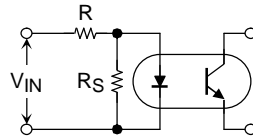


図 2.3

非発光順電圧を V_T とした場合、オフレベル入力電圧 $V_{IN(OFF)}$ は、

$$V_{IN(OFF)} \approx V_T + R \cdot \frac{V_T}{R_S} = \left(1 + \frac{R}{R_S}\right) V_T$$

となります。

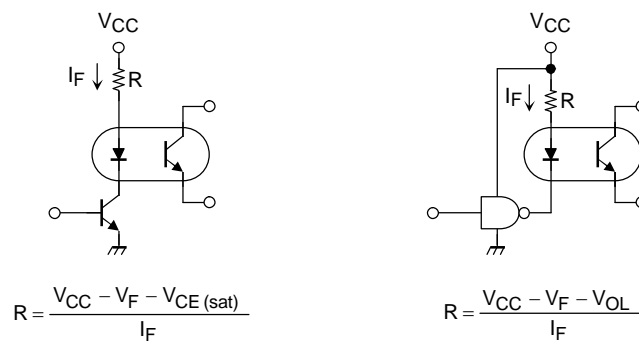
また、オフレベル入力電流 $I_{IN(OFF)}$ は、

$$I_{IN(OFF)} \approx \frac{V_T}{R_S}$$

となります。なお、当社の赤外発光ダイオードの非発光順電圧は $V_T \approx 0.5 \text{ V}$ です。

2-1-4. トランジスタまたは IC による駆動

図 2.4 にトランジスタおよび IC で駆動する場合の例を示します。



$$R = \frac{V_{CC} - V_F - V_{CE(sat)}}{I_F}$$

$$R = \frac{V_{CC} - V_F - V_{OL}}{I_F}$$

図 2.4

2-1-5. 交流電圧による駆動

この場合は整流ブリッジを図 2.5 のように使用します。

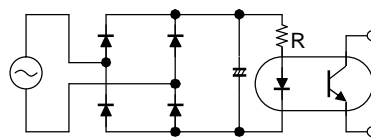


図 2.5

2-2 信号伝送用回路

信号伝送のインタフェースとしての応用には、高感度・高変換効率品が有利になります。一般に伝送ラインには、あらゆるノイズが重畳する危険性があり、受信側での対処が必要です。図 2.12 に示した中では、通常 (2) の設計が多いようですが、伝送用としてはかならずしも適しているとはいえません。同相ノイズに対してはフォトカプラの絶縁性により問題ありませんが、差動ノイズに対してはなんの工夫も施されていないからです。(3) は、差動ノイズを消去する基礎例です。この回路は一般トランジスタのベースエミッタ間に抵抗を挿入したものと同様です。特性グラフから低変換効率品より高変換効率品のほうが、しゃ断領域と飽和領域を接近することができ、きれいなスレッシュールドレベルが設計できるので、この使い方を推奨します。

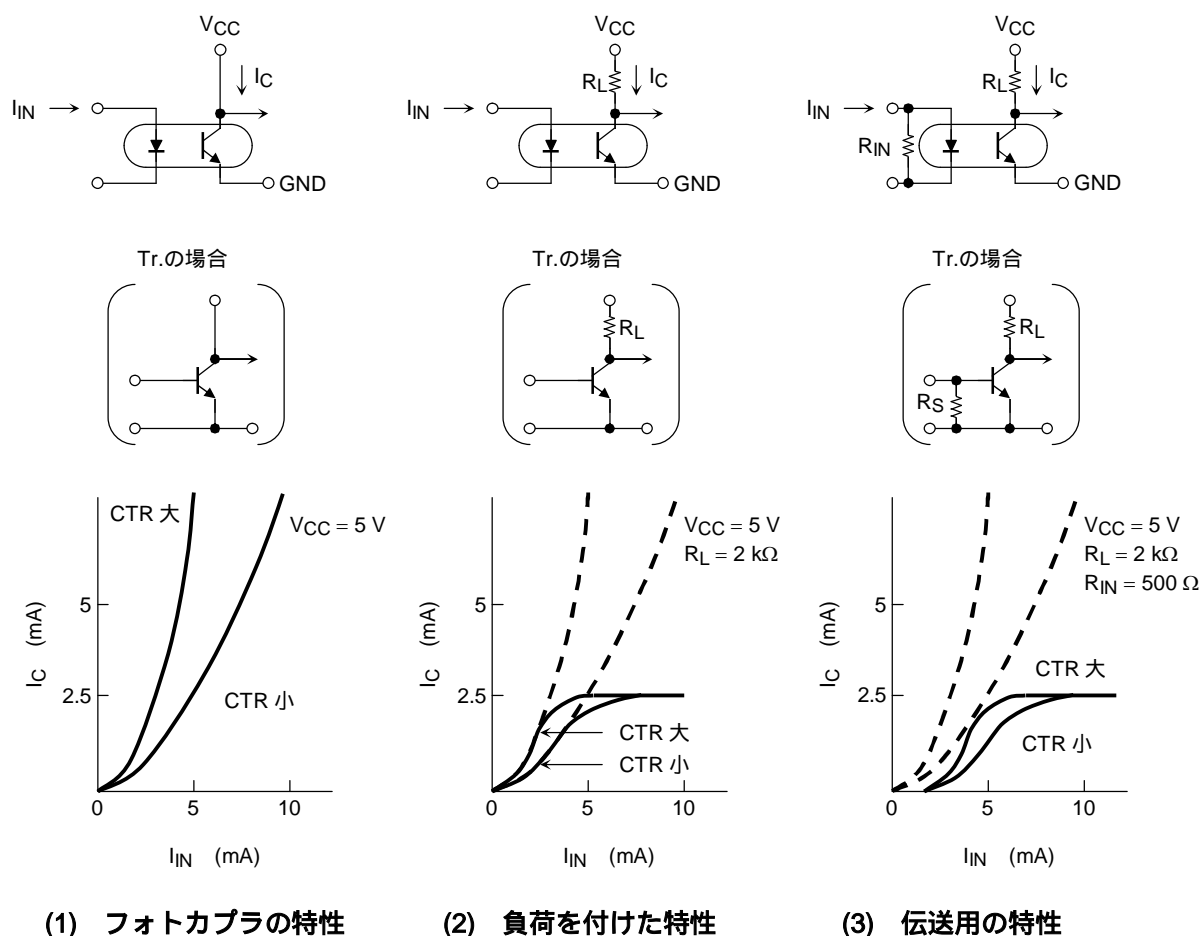


図 2.12 フォトトランジスタカプラの負荷特性例

2-3 信号伝送用回路の定数設定方法

基本的に図 2.13 がトランジスタカプラを用いた一般的な回路で、入力側に LED 電流 I_F を流すと出力側コレクタ電流 I_C が流れます。しかし、各定数を決めるためには、以下に記した諸注意が必要となります。

(1) $I_F = 0$ のとき (OFF 状態)

カプラの出力側、つまりフォトトランジスタに流れるのはリーク電流 I_D のみ ($I_C = I_D$)。このときの出力電圧 $V_{OUT(OFF)}$ は出力側の必要な High レベル電圧を V_H とすると、

$$V_{CC} - I_D \times R_L = V_{OUT(OFF)} > V_H$$

を満足させる必要があります。 (V_{CC} = 印加電圧)

I_D は図 2.14 からわかるように周囲温度が上昇すると対数的に大きくなるため、 I_D は最悪状態、つまり動作温度最大値での数値を選ぶ必要があります。これらから R_L の抵抗値は、

$$R_L < \frac{V_{CC} - V_H}{I_D}$$

を満足する必要があります。

(2) $I_F = I_{in}$ のとき (ON 状態)

カプラの出力側、つまりフォトトランジスタに流れる電流を I_C とし、出力側の必要な Low レベル電圧を V_L とすると、出力電圧 $V_{OUT(ON)}$ は、

$$V_{CC} - I_C(ON) \times R_L = V_{OUT(ON)} < V_L$$

となります。従って、

$$R_L > \frac{V_{CC} - V_L}{I_C(ON)}$$

を満足する必要があります。

通常 R_L が大きくなるとスイッチング応答性が悪くなるため、できるだけ小さい値をとることが重要です。

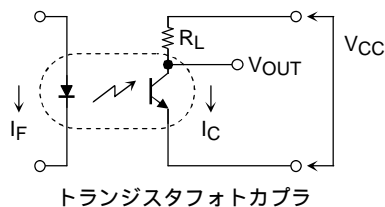


図 2.13 トランジスタフォトカプラ

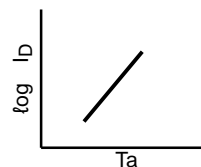


図 2.14 I_D - T_a 特性例

(3)ON 状態での入力電流 I_{in} への考慮

一般に技術資料には図 2.15、図 2.16 などの各種の特性グラフが記されています。 $I_C - I_F$ の関係は図 2.15 に示され、ある基準点 (図 2.15 の) で CTR 測定管理されています。この基準点 と実際の動作点とはズレがあるため、次の手順で設計が必要となります。

(-1) 通常、技術資料には A (あるサンプルの $I_C - I_F$ 特性例) が記載されています。

始めに CTR_{min} 品での $I_C - I_F$ 予想特性 B を、A と並行に引きます。

ここで、 $I_{C\ min} = CTR_{min} \times I_{F1}$ です。

() $I_C = I_C(ON)$ と特性 B との交点 から I_{F2} が得られます。

この I_{F2} が、 $T_a = 25^\circ C$ 、動作時間 $t = 0$ での必要な入力電流ですが、CTR の経時変化 (図 2.17)、CTR の温度特性 (図 2.16) を考慮すると、最低入力電流 I_{in} は、

$$I_{in} > I_{F2} \times \frac{1}{D_{T_a}} \times \frac{1}{D_t} \times \alpha$$

を満たす必要があります。

D_t : ある時間経過後の CTR 劣化率

D_{T_a} : 動作温度内での CTR 変動率

α : 設計マージン

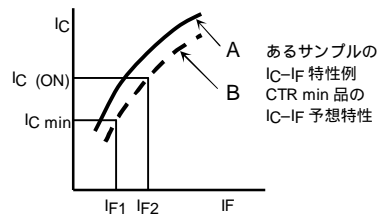


図 2.15 $I_C - I_F$ 特性例

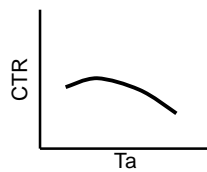


図 2.16 CTR- T_a 特性例

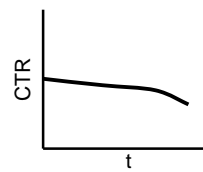


図 2.17 CTR-t 特性例

2-4 フォトランジスタカプラを使ったインターフェース回路の設計

図 2.18 は TTL 間インタフェースに DIP4 ピンのフォトカプラを使った回路です。TTL の確実な ON/OFF 動作を得るため、 R_C と I_{IL} で決まる I_{OL} を満たすための LED 電流 I_F 、コレクタ電流 I_C が必要です。

設計仕様例

動作温度 T_{opr}	: 0~70°C
データ速度	: 5 kbit/s
電源電圧	: $V_{CC} = 5V \pm 5\%$
動作寿命	: 10年 (8.8万時間)
システム稼働率	: 50%

フォトカプラの選定を行います。

今回は TLP785 の一般品から設計を始めます。設計に必要な規格を表 2.1 に示します。

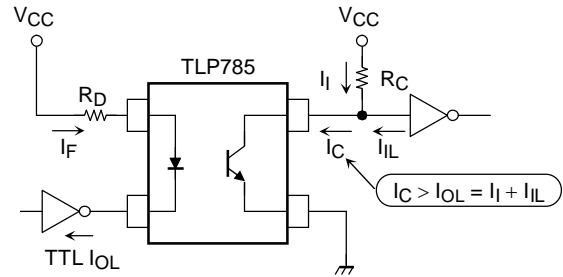


図 2.18 4 ピンのフォトカプラを使った TTL 間インタフェース回路

表 2.1 フォトカプラの主要特性

項目	記号	測定条件 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)	最小値	標準値	最大値	単位	
順電圧	V_F	$I_F = 10\text{ mA}$	1.0	1.15	1.3	V	
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 0.5\text{ mA}$	80	—	—	V	
エミッタ・コレクタ間電圧	$V_{(BR)ECO}$	$I_E = 0.1\text{ mA}$	7	—	—	V	
暗電流	I_{CEO}	$I_F = 0, V_{CE} = 24\text{ V}$	—	0.01	0.1	μA	
		$I_F = 0, V_{CE} = 24\text{ V}, T_a = 85^\circ\text{C}$	—	0.6	50	μA	
変換効率	CTR (I_C/I_F)	$I_F = 5\text{ mA}$ $V_{CE} = 5\text{ V}$	一般品	50	—	600	%
			GB ランク	100	—	600	
			GR ランク	100	—	300	
			BL ランク	200	—	600	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_F = 8\text{ mA}, I_C = 2.4\text{ mA}$	—	0.2	0.4	V	

2-4-1. 順電流 I_F の設定

I_F の最大は入力側 TTL の出力ローレベル吸い込み電流最大値 I_{OL} よりも小さくなければなりません。標準的な TTL I_{OL} を 16mA とすると $I_F \leq \text{TTL } I_{OL}$ から、 $I_F \leq 16 \text{ mA}$ となります。また I_F の最大許容値は図 2.19 から $I_F \leq 38 \text{ mA}$ ですが、変換効率 CTR の経年変化が I_F の増大により大きくなりますので、必要最小限にします。図 2.20 は CTR の経年変化例を示すものですが今回は 10 年 (約 8.8 万時間、稼働率 50% で 4.4 万時間) の動作寿命を期待するため CTR の劣化を約 50% ($D_t = 0.5$) と考えます。CTR は $I_F = 5 \text{ mA}$ で規定されていますので $I_F = 5 / 0.5 = 10 \text{ mA}$ に仮決定します。

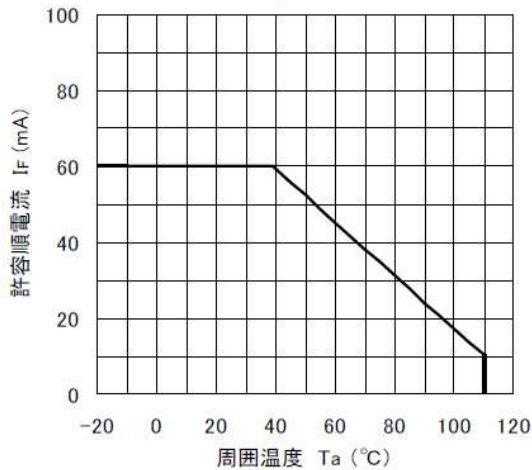


図 2.19 周囲温度-許容順電流 (TLP785)

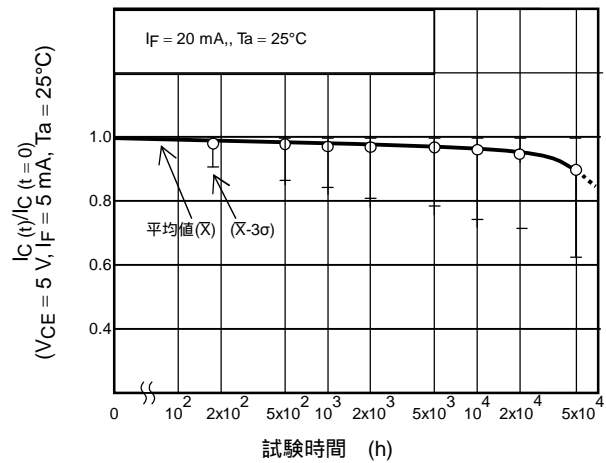


図 2.20 寿命試験データ例*

*本データは CTR 経年劣化カーブの一例を示しております。TLP785 を含めた各製品の実際の回路設計の際には個別製品の信頼性情報をご確認の上適切な設計をお願い致します。

2-4-2. I_F 制限抵抗 R_D の設定

$I_{F(\text{typ.})}$ は、

$$I_{F(\text{typ.})} = \frac{V_{CC} - V_{F(\text{typ.})} - V_{OL}}{R_{D(\text{typ.})}}$$

で示されます。

$V_{F(\text{typ.})}$ はカタログ値から、

$$V_{F(\text{typ.})} = 1.15 \text{ V } (I_F = 10 \text{ mA})$$

ですので、

$$R_D = \frac{5\text{V} - 1.15\text{V} - 0.4\text{V}}{10\text{mA}}$$

$$= 345 \Omega$$

よってここでは $R_D = 330 \Omega \pm 5\%$ を選択します。

$I_{F(\text{min.})}$ 、 $I_{F(\text{max.})}$ 値を確認しますと、下記のようになります。

$$I_{F(\text{min.})} = \frac{V_{CC(\text{min.})} - V_{F(\text{max.})} - V_{OL}}{R_{D(\text{max.})}}$$

$$= \frac{4.75\text{V} - 1.3\text{V} - 0.4\text{V}}{314\Omega}$$

$$= 9.7 \text{ mA}$$

$$I_{F(\text{max.})} = \frac{V_{CC(\text{max.})} - V_{F(\text{min.})} - V_{OL}}{R_{D(\text{min.})}}$$

$$= \frac{5.25\text{V} - 1.0\text{V} - 0.4\text{V}}{347}$$

$$= 11.1 \text{ mA}$$

2-4-3. R_C (max) の設定

R_C (max) はフォトカプラのスイッチング時間と最大動作温度での暗電流 I_{CEO} (max) の両方、または片方で設定します。

データ速度は 5 kbit/s ですから、スイッチング時間の合計は、

$$T = t_r + t_d + t_f + t_s \leq 200 \mu\text{s}$$

を満たす必要があります。

スイッチング時間は CTR(変換効率)や R_L (負荷抵抗) や T_a (周囲温度)など様々な条件により変化します。今回はこれら変動を特性データから考慮して R_L を計算します。実際の設計の際には各製品のデータシートや実力を確認の上、 I_F , V_{CC} 等の影響も考慮した設定を行ってください。今回は 200 μs に対してマージンを考慮して $T = 100 \mu\text{s}$ となるよう設計を進めます。

まず、スイッチング時間と CTR の関係を確認します。図 2.21 に示すデータを確認すると、CTR が高くなると t_{OFF} ($=t_s + t_f$) が遅くなる傾向があることが分かります。これは CTR が大きい製品ではフォトトランジスタの h_{FE} が高くなる傾向があるからです。スイッチング時間の制限がある場合には小さい CTR ランクの製品を使用したほうが有利です。

今回の $T = 100 \mu\text{s}$ の条件に対しては CTR フリーランク(50 ~ 600%)でも問題なさそうに思いますが、スイッチング時間は製品によるばらつきがあり、例えば同じ CTR=200%程度でも製品によって t_{OFF} に 10 μs 程度の差があることがグラフから分かります。このような製品のばらつきや他の T_a , R_L 等による変動分も考慮して、今回は GR ランク(100 ~ 300 %)の製品を採用します。

次にスイッチング時間の T_a 依存性(CTR=300%の製品)を図 2.22 に示します。 $T_a=25^\circ\text{C}$ から 70°C へ変化したときの増加率はおおよそ 40%ですので、温度変化を考慮すると $T = 100 / 1.4 < 70\mu\text{s}$ が必要です。

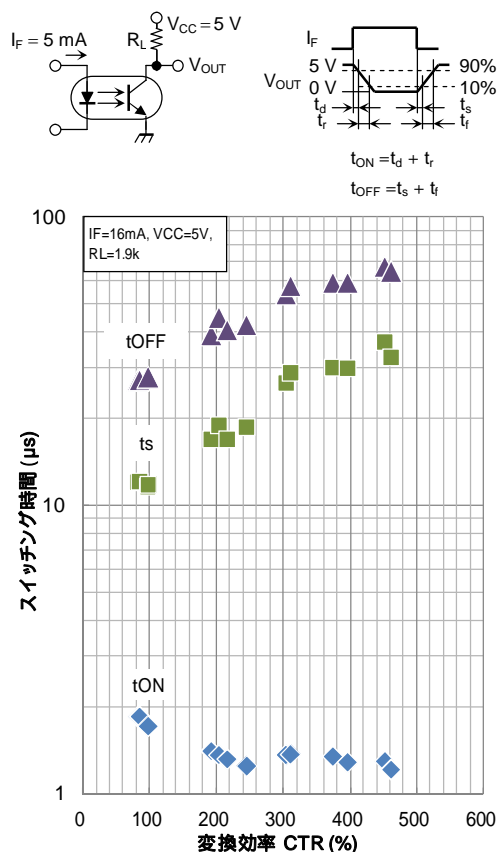


図 2.21 CTR-スイッチング時間 (飽和動作) 特性

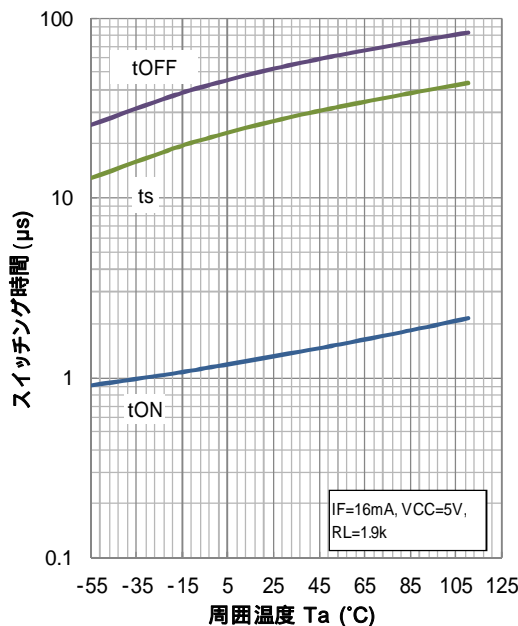


図 2.22 周囲温度-スイッチング時間 (飽和動作) 特性

最後に図 2.23 のスイッチング時間 (飽和動作) 特性グラフから R_L を求めます。グラフより $T < 70\mu\text{s}$ となる $R_L \leq 3\text{k}\Omega$ が求められます。 R_L は標準 TTL の入力抵抗 R_{IN} と R_C との並列抵抗で表すことができます(図 2.24)。

$$R_L = R_C // R_{IN}$$

ここで、

$$R_L = 1 / ((1 / R_C) + (1 / R_{IN})) \quad 3\text{k}\Omega$$

ですので、 $R_{IN} = 4\text{k}$ とすると

$$R_C \quad 12\text{k}\Omega \text{ と上限が定まります。}$$

次に暗電流 $I_{CEO(max)}$ に対する $R_{C(max)}$ の制限を確認します。 $R_{C(max)}$ は、

$$R_{C(max)} = \frac{V_{CC(min)} - V_{IH}}{I_{CEO}}$$

となります。ここで V_{IH} は TTL のハイレベル入力電圧を示します。

次に、 $T_a = 70^\circ\text{C}$ での $I_{CEO(max)}$ を推定します。

図 2.25 に $V_{CE} = 5\text{V}/10\text{V}/24\text{V}$ をパラメータにした $I_{CEO(typ.)}$ の温度依存性を示します。

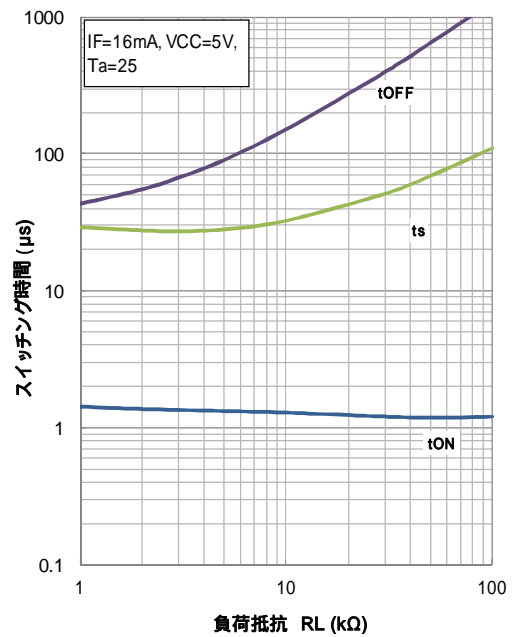


図 2.23 負荷抵抗-スイッチング時間 (飽和動作) 特性

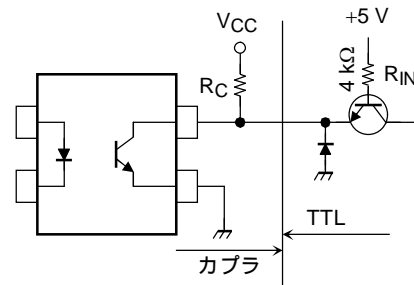


図 2.24 R_L は R_{IN} と R_C で表せる

TLP785 は、 $T_a = 85^\circ\text{C}$ 、 $V_{CE} = 24\text{ V}$ で $I_{CEO(\text{max})} = 50\ \mu\text{A}$ ですので、図 2.25 から V_{CE} 依存度と T_a 依存度を考慮して、

$T_a = 70^\circ\text{C}$ 、 $V_{CE} = 5\text{ V}$ の $I_{CEO(\text{max})}$ を推定します。

V_{CE} 依存度 : $V_{CE} = 24\text{ V} \rightarrow 5\text{ V}$

で、 $I_{CEO(\text{typ.})}$ は 1/3 倍になり、

T_a 依存度 : $T_a = 85^\circ\text{C} \rightarrow 70^\circ\text{C}$

で、 $I_{CEO(\text{typ.})}$ は 1/4 倍になります。従って、 $T_a = 70^\circ\text{C}$ 、 $V_{CE} = 5\text{ V}$ での $I_{CEO(\text{max})}$ は、

$$I_{CEO} = 50\ \mu\text{A} \times \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = 4.2\ \mu\text{A}$$

と推定されます。従って出力側 TTL のハイレベル入力電流 $I_{IH} = 40\ \mu\text{A}$ として

$$R_{C(\text{max})} = \frac{4.75\text{V} - 2\text{V}}{4.2\ \mu\text{A} + 40\ \mu\text{A}} = 62\ \text{k}\Omega$$

となります。

これはスイッチング時間から設定した $12\ \text{k}\Omega$ よりも大きい値ですので、 $R_{C(\text{max})}$ はスイッチング時間から設定した $12\ \text{k}\Omega$ を採用します。

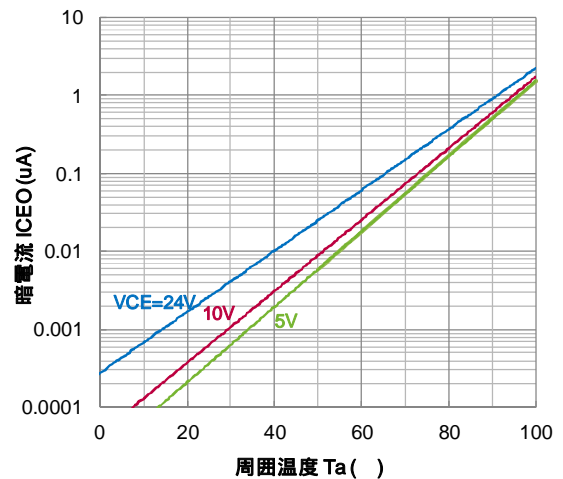


図 2.25 V_{CE} をパラメータにした周囲温度-暗電流特性

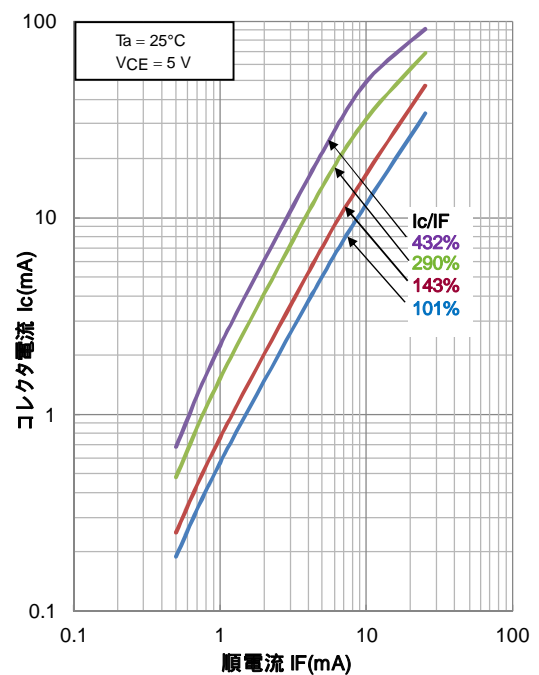


図 2.26 I_C/I_F をパラメータにした順電流-コレクタ電流特性

2-4-4. プルアップ抵抗 R_C の設定

ワーストケースの I_C 値を $\text{min}I_C$ としますと、

$$R_C \geq \frac{V_{CC(\text{max})} - V_{OL}}{\text{min}I_C - I_{IL}}$$

$$\text{min}I_C = I_{C(\text{min})} \times D_{IF} \times D_t \times D_{VCE} \times D_{Ta}$$

で表します。ここで、

D_t : ある時間経過後の I_C 劣化率

D_{IF} : カタログ条件に対する I_F 設定値での I_C 変化率

D_{VCE} : $V_{CE(\text{sat})}$ 状態での I_C 低下率

D_{Ta} : T_{opr} 内での I_C 変動率

とした場合、これらの値は各メーカーのカタログデータから得られます。TLP785 の場合、

図 2.20 より $D_t = 0.5$

($t = 4.4 \times 10^4$ h 50%稼働率)

図 2.26 より $D_{IF} = 2.3$ ($I_F = 10$ mA)

図 2.27 より $D_{VCE} = 0.7$ ($V_{CE} = 0.4$ V)

図 2.28 より $D_{Ta} = 0.75$ ($T_a = 70^\circ\text{C}$)

また、スイッチング時間の項目で CTR は GR ランク (100~300%) を選択したので $I_{C(\text{min})} = 5$ mA

[($I_F = 5$ mA) \times ($I_C/I_F(\text{min}) = 100\%$)] より、

$$\text{min}I_C = 5 \text{ mA} \times 2.3 \times 0.5 \times 0.7 \times 0.75$$

$$= 3 \text{ mA}$$

となります。ここで TTL の入力ローレベル吐き出し電流 $I_{IL} = 1.6$ mA として、

$$R_{C(\text{min})} = \frac{5.25\text{V} - 0.4\text{V}}{3.0\text{mA} - 1.6\text{mA}} \approx 3.5\text{k}\Omega$$

となります。つまり、 $R_C = 3.5$ k Ω ~ 12 k Ω の範囲内から選ぶ事ができますが、システムに要求されるデータ速度のマーヅン設定、およびロジック的 ON/OFF の確実性の両者を考慮して R_C を設定します。スピードを重視する場合なら $R_{C(\text{min})}$ に近い値を選びますが、ON/OFF の確実性 (これを動作寿命と考えてもよい) を重視するときは、 $R_{C(\text{max})}$ に近い値を選びます。今回は $D_t = 0.5$ と比較的大きいマーヅンを取っていますので、動作寿命については余裕があると考え、スピードを重視して $R_C = 4.7$ k Ω としました。

以上の内容より、回路定数は $R_D = 330\Omega$, $R_C = 4.7$ k Ω と決めましたが、実機での動作・波形の確認を十分にいき最終的な回路定数の調整を行ってください。システムに要求されるデータ速度が速い場合には、スイッチング時間の最大値を保証している IC フォトカプラもご検討ください。

今回は TTL を用いて回路設計を行いました。CMOS を用いた場合も考え方は同様です。CMOS の場合には I_{IL} や I_{IH} が TTL よりも小さい値になる事や入力電圧のレベルが TTL と異なるなどの違いがありますので、ご使用になる CMOS の特性に留意して設計を行ってください。

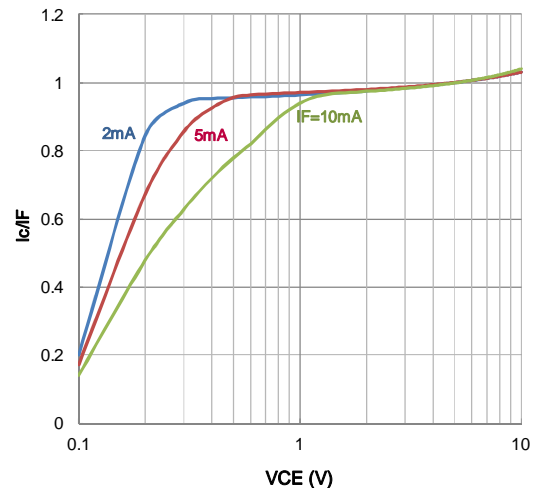


図 2.27 I_C/I_F - V_{CE} 特性

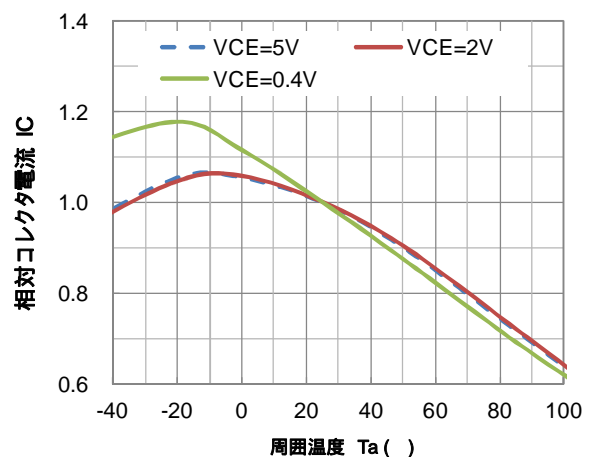


図 2.28 周囲温度 - コレクタ電流特性

*本資料に掲載されている特性データは代表サンプルによる特性例です。

3.用語説明

(フォトプラ共通)

用 語	記 号	説 明
絶 对 最 大 定 格		動作中に瞬時といえども超えてはならない最大値
絶 縁 耐 圧	BVs	入力・出力間の絶縁耐量を保証する電圧
端 子 間 容 量	C _{CE}	トランジスタコレクタ端子-エミッタ端子間の静電容量
入 出 力 間 浮 遊 容 量	C _S	入力端子-出力端子間の静電容量
端 子 間 容 量	C _T	LED アノード端子-カソード端子間の静電容量
直 流 順 電 流	I _F	連続的に LED 順方向に流し得る電流定格
パ ル ス 順 電 流	I _{FP}	瞬時的に LED 順方向に流し得る電流定格
過 度 パ ル ス 順 電 流	I _{FPT}	瞬時的に LED 順方向に流し得る電流定格
逆 電 流	I _R	LED 逆方向 (カソード-アノード間) に流れる漏れ電流
許 容 損 失	P _D	LED で許容し得る電力損失定格
	P _T	入力・出力の全回路で許容し得る電力損失定格
絶 縁 抵 抗	R _S	規定の電圧値での入力端子-出力端子間の抵抗値
接 合 部 温 度	T _j	チップのジャンクション部で許容し得る温度定格
動 作 温 度	T _{opr}	素子の機能を損なうことなく動作させ得る周囲温度範囲
は ん だ 付 け 温 度	T _{sol}	素子の機能を損なうことなく端子をはんだ付けするための温度定格
保 存 温 度	T _{stg}	素子を動作させない状態で保存し得る周囲温度範囲
順 電 圧	V _F	規定の順電流値での LED アノード-カソード間電圧
直 流 逆 電 圧	V _R	カソード-アノード間に印加し得る逆電圧定格

(トランジスタ出力)

用語	記号	説明
直流電流増幅率	h_{FE}	受光トランジスタの h_{FE}
コレクタ電流	I_C	コレクタに流し得る電流定格
変換効率	I_C/I_F (CTR)	入力 LED 電流 I_F に対する出力電流 I_C の比 : $I_C/I_F \times 100$ (単位%)
暗電流	I_{CEO}	コレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流
ベ-ス光電流	I_{PB}	規定の入力電流 I_F で受光側ベース部に発生する光電流
コレクタ損失	P_C	コレクタで許容し得る電力損失定格
立ち下がり時間	t_f	出力波形の 90% から 10% まで遷移するのに要する時間
ターンオフ時間	t_{OFF}	入力オン → オフ時点から、出力波形が 0 (100) % から 90 (10) % まで遷移するのに要する時間
ターンオン時間	t_{ON}	入力オフ → オン時点から、出力波形が 0 (100) % から 90 (10) % まで遷移するのに要する時間
立ち上がり時間	t_r	出力波形の 10% から 90% まで遷移するのに要する時間
蓄積時間	t_s	入力オン → オフ時点から、出力波形が 0 (100) % から 10 (90) % まで遷移するのに要する時間
コレクタ-ベース間降伏電圧	$V_{(BR) CBO}$	エミッタを開放にしたときのコレクタ-ベース間の降伏電圧値
コレクタ-エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR) CEO}$	ベースを開放にしたときのコレクタ-エミッタ間の降伏電圧値
エミッタ-ベース間降伏電圧	$V_{(BR) EBO}$	コレクタを開放にしたときのエミッタ-ベース間の降伏電圧値
エミッタ-コレクタ間降伏電圧	$V_{(BR) ECO}$	ベースを開放にしたときのエミッタ-コレクタ間の降伏電圧値
コレクタ-エミッタ間飽和電圧	$V_{CE (sat)}$	規定の飽和条件におけるコレクタ-エミッタ間の電圧
コレクタ-ベース間電圧	V_{CBO}	コレクタ-ベース間に印加し得る電圧定格
コレクタ-エミッタ間電圧	V_{CEO}	コレクタ-エミッタ間に印加し得る電圧定格
エミッタ-ベース間電圧	V_{EBO}	エミッタ-ベース間に印加し得る電圧定格
エミッタ-コレクタ間電圧	V_{ECO}	エミッタ-コレクタ間に印加し得る電圧定格
コレクタオフ電流	$I_C (off)$	入りに低電圧を印加したときのコレクタ-エミッタ間に流れる漏れ電流

製品取り扱い上のお願ひ

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品には GaAs（ガリウムヒ素）が使われています。その粉末や蒸気等は人体に対し有害ですので、破壊、切断、粉碎や化学的な分解はしないでください。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。